

DHA[®]

QJ/DHA 09.30-2018

LD634

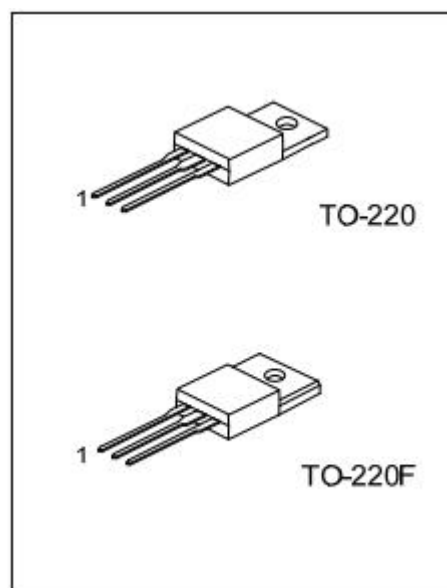
N-沟道 MOSFET 功率晶体管

描述

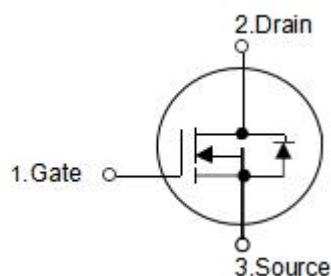
N 沟道 MOSFET 采用塑料 TO220 封装。符合 RoHS。

用途

适用于高速开关, 不间断电源, 电机控制, 音频放大器, 工业执行器。用于电信, 工业和消费者环境的 DC-DC 和 DC-AC 转换器。



等效电路图

电参数 (T_{amb} = 25°C)

| 缩写 | 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
|---------------------|------------------|----|-------------|------|------|---|
| BV _{DSS} | 漏极-源极 击穿电压 | V | 250 | - | - | V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA |
| I _D | 漏极连续电流 | A | - | - | 8.1 | T _j = 25 °C |
| R _{DS(on)} | 静态 漏极-源极 导通电阻 | Ω | - | 0.37 | 0.45 | V _{GS} = 10 V, I _D = 4.05 A |
| V _{GS(th)} | 栅极门限电压 | V | 2.0 | - | 4.0 | V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA |
| I _{DSS} | 漏极-源极 漏电流 | μA | - | - | 1 | V _{DS} = 250 V, V _{GS} = 0 V |
| I _{GSS} | 栅极-源极 漏电流 | nA | - | - | 100 | V _{GS} = ± 25 V, V _{DS} = 0 V |
| T _j | 工作结温 | °C | - 55 ~ +150 | | | |
| T _{STG} | 储存温度范围 | °C | | | | |

丹东华奥电子有限公司

<http://www.huaoe.com>